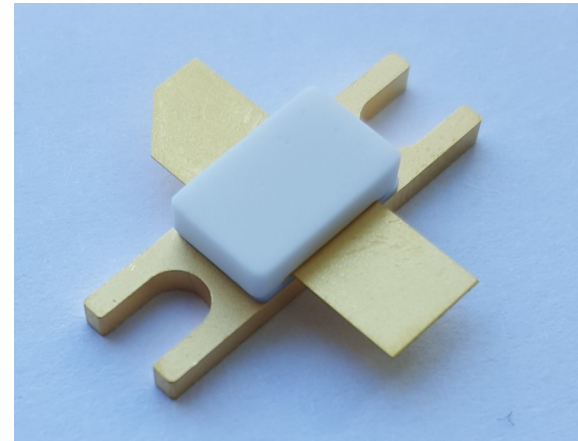


RT802P

75 Вт, 1-6 ГГц, GaN HEMT, PACKAGE TYPE

RT802P, это GaN транзистор с высокой подвижностью электронов на подложке из SiC, имеет высокий КПД, высокий коэффициент усиления, а также широкую рабочую полосу частот от 1 до 6 ГГц. Транзистор имеет характеристики соответствующие мировому уровню. Предназначен для использования в радиолокации и радиосвязи, имеют высокую надежность. Возможно изготовление транзисторов в керамическом корпусе с внутренними согласующими цепями.



ОСОБЕННОСТИ

- Верхняя частота: 6 ГГц
- Максимальная выходная СВЧ мощность: 75 Вт
- Максимальное усиление: 15 дБ, на 6 ГГц
- КПД не менее: 42%
- Напряжение питания: 28 В
- Размер корпуса: 8 x 6,5 мм

Электрические характеристики $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{ds}=28\text{ В}$

Характеристика	Минимальное	Типичное	Максимальное	Ед. измерения	Условия
Ток сток-исток	10.5	11.9	13.3	А	$V_{gs}=0\text{В}$
Ток сток-исток	14.8	15.9	16.8	А	$V_{gs}=1\text{В}$
Пороговое напряжение затвора	-2.94	-2.6	-2.28	В	
Напряжение пробоя затвор-сток	116	119	120	В	$V_g=-10\text{В}$
Сопротивление включённого транзистора	0.16	0.17	0.18	Ом	

СВЧ характеристики $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{ds}=28\text{ В}$

Характеристика	Минимальное	Типичное	Максимальное	Ед. измерения	Условия
Выходная мощность			75	Вт	$f=4\text{ ГГц}$
Коэффициент усиления		15		дБ	на малом
КПД	42			%	
Частота	1		6	ГГц	

Основные размеры корпуса:

